

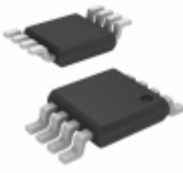
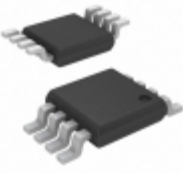


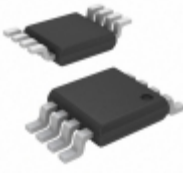



	<h2 style="color: red;">SI6981DQ-T1-GE3</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI6981DQ-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8-TSSOP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI6981DQ-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI6981DQ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8-TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 300µA
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	31 mOhm @ 4.8A, 4.5V
Leistung - max	830mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A

SI6981DQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6981DQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6981DQ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI6981DQ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI6975DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 4.3A 8TSSOP</p>	 <p>SI6981DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8-TSSOP</p>	 <p>SI6991DQ-T1-E3 VISHAY SI6991DQ-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI6983DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.6A 8TSSOP</p>
 <p>SI6983DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.6A 8TSSOP</p>	 <p>SI6981DQ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8-TSSOP</p>	 <p>SI6983DQ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.6A 8TSSOP</p>	 <p>SI6981DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8-TSSOP</p>

SI6981DQ-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SI6981DQ-T1-GE3 / Siliconix	SI6981DQ-T1-GE3 Datenblatt	SI6981DQ-T1-GE3 -Datenblätter	SI6981DQ-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI6981DQ-T1-GE3
SI6981DQ-T1-GE3 Electronic	SI6981DQ-T1-GE3 Preis	SI6981DQ-T1-GE3 Komponenten	SI6981DQ-T1-GE3 Hersteller	SI6981DQ-T1-GE3 Verteiler	SI6981DQ-T1-GE3 Bild
SI6981DQ-T1-GE3 Neu	SI6981DQ-T1-GE3 Original	SI6981DQ-T1-GE3 garantiert	SI6981DQ-T1-GE3 RFQ	SI6981DQ-T1-GE3 Anteil	SI6981DQ-T1-GE3 Inventar
				SI6981DQ-T1-GE3 Online bestellen	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited